Групповой проект. Тема: Рост дендритов

Этап 3

Артамонов Тимофей Евгеньевич Федорина Эрнест Васильевич Морозов Михаил Евгеньвич Коротун Илья Игоревич Маслова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Введ	дение	4												
2	and the control of th														
	2.1	Шаг 0 Используемые библиотеки	5												
	2.2	Шаг 1 Параметры модели	5												
	2.3	Шаг 2 Инициализация сетки	6												
	2.4	Шаг 3 Параметры для условия Стефана	6												
	2.5	Шаг 4 Функция роста	7												
	2.6	Шаг 5 Визуализация итогового состояния	8												
	2.7	График модели	9												
3	Выв	од	10												

Список иллюстраций

2.1	plot									_								_		9

1 Введение

На третьем этапе группового проекта нужно описание программную реализацию проекта. На прошлом этапе мы уже рассмотрели алогритм по которому мы будем двигаться при выполнении этого этапа. Приступим к описанию кода.

2 Моделирование роста дендритов

2.1 Шаг 0 Используемые библиотеки

- using Plots: Библиотека для визуализации данных. В данном коде используем для создания тепловой карты, отображающей состояние сетки после симуляции роста дендритов.
- using LinearAlgebra: Библиотека для работы с линейной алгеброй. Используем, для операций с векторами и матрицами в вычислениях.

using Plots
using LinearAlgebra

2.2 Шаг 1 Параметры модели

Указываем основные параметрыры моделирования:

N: размер сетки, представляющий собой квадратную сетку N х N, на которой будет происходить моделирование. Т_melt: температура плавления, определяющая порог, при котором материал начинает затвердевать. growth_chance: увеличенный шанс роста дендритов в соседние ячейки, это вероятность, с которой новые дендриты будут расти в окружающие зоны с пониженной температурой. steps: количество шагов симуляции, определяющее, сколько раз будет произведено обновление состояния сетки.

```
N = 100
T_melt = 1.0
growth_chance = 0.005
steps = 8000
```

2.3 Шаг 2 Инициализация сетки

Создаем матрицу Т размером N x N, инициализируя ее нулями. Задаем начальную затравочную область в виде круга с заданным радиусом и центром.

```
T = zeros(N, N)

# Увеличение размера начальной затравочной области

center = div(N, 2)

radius = 1 # Радиус затравочной области

for i in (center-radius):(center+radius)

    for j in (center-radius):(center+radius)

        T[i, j] = T_melt
    end

end
```

2.4 Шаг 3 Параметры для условия Стефана

Определяем коэффициенты теплопроводности, плотности, латентной теплоты и температуру на границе. Используем эти парамметры для вычисления скорости роста кристалла по условию Стефана.

```
    ■ = 0.1 # Теплопроводность

    ■ = 1.0 # Плотность
```

```
L = 1.0 # Латентная теплота

Tb = T melt # Температура на границе
```

2.5 Шаг 4 Функция роста

Эта функция выполняет основную часть моделирования роста дендритов. Она итерирует указанное количество шагов по сетке и обновляет ее состояние в соответствии с правилами роста кристалла и уравнением теплопроводности.

Уравнение теплопроводности:

- 1.Создается временная копия текущего состояния сетки Т.
- 2.Перебираются все внутренние ячейки сетки.
- 3. Если температура в ячейке равна температуре плавления, вычисляется градиент температуры в соседних ячейках.
- 4.Для каждой соседней ячейки вычисляется градиент температуры и скорость роста кристалла по условию Стефана.
- 5. Если случайное число меньше произведения шанса роста на скорость роста, ячейка затвердевает на следующем шаге, и это отражается во временной копии сетки.

Обновление основной сетки: После завершения всех шагов симуляции, основная сетка T обновляется копией T temp.

```
# Вычисляем градиенты температуры в соседних ячей
                                          \mathbf{Z}T_s = [T[i+di, j+dj] - T[i, j] \text{ for (di, dj) in } [
                                          \mathbf{Z}\mathbf{T}_{l} = [\mathbf{T}\mathbf{b} - \mathbf{T}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] \text{ for } \mathbf{n} \ 1:4]
                                          # Умножаем градиенты для диагональных элементов н
                                          XT_s[1] /= 2
                                          XT_s[2] /= 2
                                          # Вычисляем вектор нормали к границе затвердевани
                                          n = [di + dj \text{ for } (di, dj) \text{ in } [(-1, 0), (1, 0), (0)]
                                          # Вычисляем скорость роста кристалла по условию (
                                          v = \boxtimes / (\boxtimes * L) * dot(n, \boxtimes T_s - \boxtimes T_l)
                                          if rand() < growth_chance * v</pre>
                                               T_{temp[i+di, j+dj]} = T_{melt} + 3атвердевание
                                          end
                                     end
                                end
                          end
                     end
                end
          end
          Т .= T temp # Обновляем основную сетку
     end
end
```

2.6 Шаг 5 Визуализация итогового состояния

После выполнения симуляции функцией роста, код строит тепловую карту (heatmap) для визуализации конечного состояния сетки Т.

#Выполнение симуляции

grow_crystals_stefan!(T)

#Визуализация итогового состояния

p = heatmap(T, color=:ice, aspect_ratio=1, title="Модель роста дендритов с услови
display(p)

2.7 График модели

Модель роста дендритов с условием Стефана

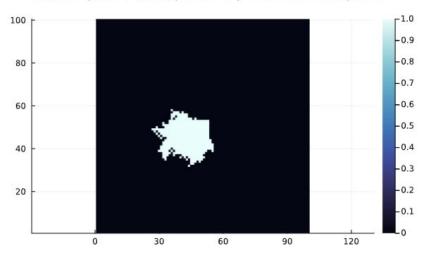


Рис. 2.1: plot

3 Вывод

Модель роста дендритов, реализованная с использованием условия Стефана и уравнения теплопроводности, позволяет имитировать процесс затвердевания материала и формирования кристаллических структур. После завершения всех шагов симуляции, модель предоставляет визуализацию итогового состояния сетки с помощью тепловой карты.